

No.135	ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発（助成）（e4）高メモリ密度・広帯域・低消費電力な革新的メモリの製造技術開発【GX】	
機関名	国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構	
募集締切（公募機関）	2025年12月8日(月)正午アップロード完了	
本部研推締切日	研究推進部 事前連絡締切日	2025年11月21日(金)
	原議書提出締切日	2025年12月1日(月)
応募方法	WEB入力フォームによる提出及びe-R a dによる提出 ※本公募は事務局において事前了解の手続きを行いますが、Web入力フォームへの提出及びe-R a dへの応募情報の入力には各申請者が行ってください。	
所属研究機関の承認(e-Rad)	不要	
研究推進部 事前了解 (原議書の回付)	必要	
概 要	第4世代移動通信システム（4G）と比べてより高度な第5世代移動通信システム（5G）は、現在各国で商用サービスが始まっていますが、更に超低遅延や多数同時接続といった機能が強化された5G（以下、「ポスト5G」という。）は、今後、工場や自動車といった多様な産業用途への活用が見込まれており、我が国の競争力の核となり得る技術と期待されています。経済産業省及びNEDOにて取り組む「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」では、研究開発の進捗や技術動向・市場動向、半導体・デジタル産業戦略検討会議での議論等を踏まえ、経済産業省が策定・改定した研究開発計画に基づき、ポスト5Gに対応した情報通信システムの中核となる技術の開発研究として、「先端半導体製造技術の開発」を実施しています。 NEDOは、本事業において将来的に、ポスト5G情報通信システムで用いられる先端半導体を国内で設計・製造できる技術を確保するため、以下の開発に取り組めます。 本公募では、研究開発計画における以下の開発テーマを対象とします。研究開発計画の要件等を満たすよう応募をしてください。 〔2〕先端半導体製造技術の開発（助成） （e）次世代メモリ技術開発 （e4）高メモリ密度・広帯域・低消費電力な革新的メモリの製造技術開発【GX】	

※ 貴部局にて申請がある場合は、事前連絡締切日までに所定の《事前連絡様式》にて、研究代表者名・研究分担者名等の連絡をお願い致します。

※応募に関するお問い合わせは各部局の担当者までお願いします。